

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-154122
(43)Date of publication of application : 27.05.1992

(51)Int.Cl. H01L 21/304
G03F 7/30
H01L 21/027

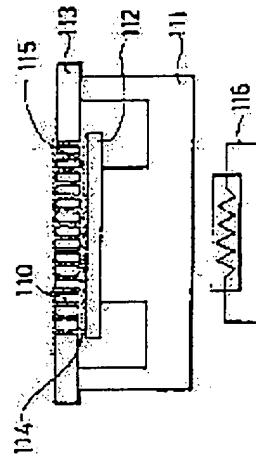
(21)Application number : 02-277677 (71)Applicant : TOSHIBA CORP
(22)Date of filing : 18.10.1990 (72)Inventor : OKUMURA KATSUYA

(54) APPARATUS AND METHOD FOR TREATMENT OF SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To execute a safe and efficient cleaning operation by using a fluid in small quantities and to eliminate a contamination by a method wherein, when only one face of a flat boardlike substrate for a semiconductor device or for a liquid-crystal display device is treated with a liquid, a plurality of through holes which are passed toward the rear form one face of a part faced with the substrate are made in a fluid-holding utensil, for liquid use, which is faced with the treatment face of the substrate so as to be close to the face.

CONSTITUTION: A silicon wafer 112 to be treated is placed on a substrate support stand 111 made of quartz; and a treatment liquid holding utensil 113 which has been bridged on both end parts of the support stand 111 is installed by keeping a prescribed interval from the wafer 112. In this constitution, a plurality of through holes 110 are made in a part faced with the wafer 112 of the holding utensil 113. An apparatus constituted in this manner is immersed in a mixed liquid of H₂SO₄ and H₂O₂ in a mixture ratio of 10:1; and an interval part 114 between the holding utensil 113 and the wafer 112 is filled with a treatment liquid 115 by means of surface tension. A lamp heater 116 is arranged and installed at the lower side of the support stand 111; the holding utensil 113 made of carbon is heated to 150 to 200° C; the temperature of the treatment liquid 115 is raised; and a contamination or the like which has adhered to the wafer 112 is removed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑫ 公開特許公報 (A) 平4-154122

⑬ Int. Cl. 5

H 01 L 21/304
G 03 F 7/30
H 01 L 21/027
21/304

識別記号 341 N 8831-4M
501 7124-2H
341 C 8831-4M
7352-4M

⑬ 公開 平成4年(1992)5月27日

H 01 L 21/30 361 R

審査請求 未請求 請求項の数 13 (全8頁)

⑭ 発明の名称 基板処理装置及び同方法

⑮ 特 願 平2-277677

⑯ 出 願 平2(1990)10月18日

⑰ 発明者 奥村 勝弥 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

⑱ 出願人 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑲ 代理人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

明細書

1. 発明の名称

基板処理装置及び同方法

2. 特許請求の範囲

(1) 被処理基板の処理面に近接対向するように配置される処理用流体保持具に、その基板対向部の一面から他面へ貫通する処理用流体通過孔を有したことを特徴とする基板処理装置。

(2) 前記保持具の前記被処理基板との対向面とは反対の面側に処理用流体の貯蔵部を有した請求項1に記載の基板処理装置。

(3) 前記保持具が折り曲げ可能である請求項1に記載の基板処理装置。

(4) 前記保持具は、その一部が被処理基板に近接しながら転送される無端ベルト状を有し、該ベルト面に処理用流体の供給部を有した請求項1に記載の基板処理装置。

(5) 前記保持具の前記被処理基板との対向面には多数の有底孔が設けてある請求項1に記載の基板処理装置。

(6) 前記保持具の前記被処理基板との対向面には、間隔的に前記被処理基板との間隙調整用の凸起部が設けられている請求項1に記載の基板処理装置。

(7) 前記処理用流体は、膜体除去用、膜体形成用、現像用、洗浄用のうちのいずれか1つである請求項1に記載の基板処理装置。

(8) 請求項1において処理用流体は処理用流体保持具に滴下されるものであることを特徴とする基板処理方法。

(9) 請求項1において処理用流体は該流体に保持具が浸漬され保持されるものであることを特徴とする基板処理方法。

(10) 請求項2において、処理用流体は該流体の貯蔵部から保持具に送られるものであることを特徴とする基板処理方法。

(11) 請求項2において、処理用流体は該流体にかかる圧力が調整されるものであることを特徴とする基板処理方法。

(12) 請求項1または2において、処理用流体の

温度制御を行なうことを特徴とする基板処理方法。

(19)請求項1または2において、板処理用流体に振動を与えることを特徴とする基板処理方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、流体（主に液体）を用いた基板の処理装置における処理方法に関するもので、特に半導体装置や液晶表示装置等の製造時に用いられる平板状基板の片面のみを液体で処理する際に好適する。

(従来の技術)

(イ) 薬液を用いた従来の基板処理法を、 H_2SO_4 と H_2O_2 を混合加熱した薬液で基板洗浄やレジスト除去を行なう方法を例として、第8図を用いて説明する。石英等で作られた薬液槽11内に薬液12として H_2SO_4 と H_2O_2 を10対1の比で全量で25L入れる。150℃で前後にまでランプヒーター13で加熱した薬液12中に複数枚の被処理基板14（本例では150mm

なる。

(ロ) シリコンウエーハ上にTABプロセスで用いられるAlバンプをメッキ法で形成する場合を第9図を用いて説明する。第9図のようなメッキ槽21にAlメッキ液22を入れ、60～70℃に加温し、ウエーハ23に対向させて電極24を設置し、直流電源25により電流を流し、ウエーハ23上にメッキをする。

(ハ) ポジタイプのフォトレジストと基板の付力を向上させるために、HMDS（ヘキサメチレンジシラン）等のシランカップリング剤処理がレジスト塗布前に行なわれることが多い。この処理法として第10図に示すように、密閉可能な容器内31にHMDS液体32と被処理基板33を入れ、密閉した後、HMDSを加熱手段34により温め、HMDSを蒸発させ、該蒸気35で基板33上にHMDS膜を形成し、カップリング剤処理がなされる。

(ニ) ポジ型フォトレジストの現像方法を第11図を用いて説明する。シリコンウエーハ41

後のレジストパターンが形成されている複数枚例えれば25枚のシリコンウエーハがウエーハホルダー15に入れられている）を浸漬し、約15分間で処理が終了した。前述の25L薬液で約500枚のウエーハ14が処理できた。

この装置とはほぼ同じもので、フッ化アンモニウム（ NH_4F ）液や希釈したフッ酸（HF）を用いてガラス層をエッチングしたり、洗浄工程に供したりすることがある。また有機アルカリの水溶液でシリコン層をエッチングする工程に用いられることがある。また、シリコンウエーハ裏面に形成された酸化膜をエッチング除去するため、ウエーハ表面全面をレジストでおおい、前述薬液処理槽に浸漬させることもある。さらにはまた、飽和状態まで溶解させた H_2SiF_6 水溶液中にAl等を溶解させ、 SiO_2 を基板上に堆積させる方法があるが、この方法にも第8図に示したような溶槽が用いられる。

液晶表示装置等の製造時には、さらに大型基板が用いられるため、該薬液処理槽はさらに大きく

を回転チャック42上に載置・固定し、該ウエーハ上のパターン露光されたレジストに現像液43をスプレーノズル44から射出させながらウエーハ41を回転させて現像を行なう方法や、ノズルから現像液を滴下させ、ウエーハ表面上に表面張力を用いて現像液を溜めて静止状態で現像する方法等がある。

(ホ) フォトレジストの従来の塗布方法を同じく第11図を用いて説明する。

スプレーノズル44から現像液のかわりにフォトレジスト43を滴下し、ウエーハ41上にレジストを盛るようにする。その後ウエーハを回転チャック42で回転させ、不要のフォトレジストを飛散させ所望の膜厚のレジスト層を得る。

(発明が解決しようとする課題)

上述の(イ)項の処理液槽11中に基板14を浸漬させる方法では、多量の処理液12を用いるため、これを複数回利用するのが常である。しかし、被処理基板14が汚れていたり、基板ホルダー15が汚染していたりすると、この汚染が処

理液中に溶けていき、この汚染がされた以降に処理された基板は、汚染されてしまうことになる。このような汚染をクロスコンタミネーションと言っている。これを回避するためには1個の処理毎に処理液を取り換えればよいが、コストが高くかかりすぎ現実的でない。また、よしんば1回ごとに処理液を交換したとしても基板裏面が汚れている場合には表面にまでこの汚染が回わり込むことになり、クロスコンタミネーションを回避することは不可能である。

また大量の処理液を処理液槽に入れて加熱したりして使用するため、もし槽が破損した場合には大事故となり、安全面に關しても問題がある。

前記(ロ)項の処理の場合、シリコンウエーハ裏面がメッキ液にさらされるため、裏面をレジスト等でおおう必要が生じ、このため数多くの工程が必要となる。また、他の問題点としては、ウエーハ23に給電する方法であるが、給電部26がメッキ液22中になるため、該給電部にAヒがメッキされ、多數枚のウエーハを連続して処理でき

なくなることであ
さらに、多量のメッキ液22を用いるため、多數枚の基板を処理するのであるが、前記(イ)項で述べたのと同じようにクロスコンタミネーションの問題も回避できなく、この場合は汚染原因によってはメッキそのものの品質が再現しなくなることもある。

前記(ハ)項の処理法の問題点としては、HMDS膜が不要なウエーハ裏面にまで形成され、これが後工程でパーティクル発生や汚染の原因となる。また容器内壁にHMDSが累積して厚く付着し、該付着膜がはがれ、パーティクルの原因となることもある。さらには容器全体をHMDS蒸気で満たすとき、濃度を均一にすることが困難でHMDS膜厚にバラツキが生じやすい。

上記の(ニ)項の現像方法の問題点は、まずスプレーで射出させながら現像すると、放射状の現像むらが生じる。静止状態で現像したほうがむらに關しては良好であるが、現像液がレジスト表面をゆっくり延展していくと、理由はよくわからないが現像むらが生じやすく、このためできるだけ

遅く現像液を基板表面に延展するのが望ましい。しかしあまり遅く延展させると表面張力が破れ現像液が静止しなくウエーハ表面からもれてしまう。また、ウエーハ保持が水平でないとものが生じたり、風や機械的な振動・ゆれ等で現像液がもれることがある。さらに、ウエーハ41が大きくなると、200mm直径まで大きくなると、もはや表面張力だけで現像液43を静止保持させておくことは困難である。

上記(ホ)項の問題点としては、レジストを回転飛散させる時レジスト中の溶剤も揮発していくためレジストの粘度が高くなっていく。このため溶剤揮発速度と飛散速度が調和しないと膜厚ばらつきが大きくなる。この現象をストリエーションと言っている。このストリエーションを最小にするため、ウエーハ上のレジスト盛り量を多くしたり回転速度や加速度を大きくすることにより解決しているが、ウエーハ直径が大きくなってくるともはやこれらだけでは解決できなくなってきている。

そこで本発明の目的は、上記クロスコンタミネーションの問題、大量の処理液を使用する問題点等を改善することにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段と作用)

本発明は、被処理基板の処理面に近接対向するように配置される処理用流体保持具に、その基板対向部の一面から他面へ貫通する処理用流体通過孔を有したことを特徴とする基板処理装置である。

即ち本発明は、例えば平板状の被処理基板と該基板の処理面に對向するように基板とはば同じ大きさの平板状でかつ多數の孔が形成された処理液保持具を近接して配置し、該保持具に処理液を保持させ所望の処理を施すもので、本発明では被処理基板の処理面にのみ処理液を保持させて処理できるため処理液はごく少量ですみ、処理毎に処理液を廃棄することができるため、クロスコンタミネーションを抑止することができ、かつ安全性および経済性も高い。

(実施例)

以下 H_2SO_4 と H_2O_2 混合液を用いてレジスト除去や基板洗浄をする方法および装置の実施例について第1図を用いて述べる。

石英で作られた基板支持台11.1上に150mm径の被処理シリコンウェーハ11.2が載置されている。図では省略したが、該ウェーハ11.2には、除去されるレジストがウェーハ表面(本実施例では上面)に付着している。直径1.5mmの貫通孔11.0が3mm間隔で150mmのほぼ円形全面(但しウェーハのオリフラ部は除く)に設けられたカーボンで製作された厚さ2mm、直径170mmの処理液保持具11.3を、 H_2SO_4 と H_2O_2 混合液(10:1混合比)に浸漬し、貫通孔11.0を処理液11.5で満たしておく。この保持具11.3をウェーハ11.2と0.5mmほどの間隔11.4をあけて配置すると、表面張力でもって保持具とウェーハの間隔部11.4が処理液11.5で満たされる。

しかして基板支持台下方に配置されているランプヒーター11.6を点灯することにより、赤外線

を吸収しやすいカーボンで作られている保持具11.3が加熱されて、すばやく処理液11.5も昇温し、レジストを高速で除去する。この時の温度は150~200℃に設定した。2~3分でレジスト除去は終了した。終了後、保持具11.3を持ちあげ、ウェーハ11.2を取り出し、次の処理されるウェーハを基板支持台に載置し、上述の工程を繰りかえしていく。

第1図のものにあっては、保持具11.3が多数の孔11.0を有しているため、上述間隔部11.4に充分な処理液11.5が保持されるのであり、かつ保持具11.3と基板11.2をはがす時、多数孔11.0を通して空気が流入するため、はがしやすくなっている。このような保持具11.3は多孔質の材料で作製しても同様の効果は得られる。当然のことながら保持具11.3は処理液におかれない材料を選定すべきである。または表面処理を施こし、耐薬性を向上させるのが望ましい。さらに保持具は、カーボンやガラスのファイバーで編んだものを用いてもよいし、紙のように漉いたものを

用いてもよい。これらのものを用いた場合は折れ曲げが可能であるため、基板からはがす時さらに容易になる。さらに、折れ曲げができない材料のものでも丸棒状のものを、すのこ状に糸等で編んでもよいし、適当な連結具を用いて束ねてもよい。

本実施例では処理液に保持具11.3を浸漬してから基板11.2上に載置したが、基板上に保持具を載置後、処理液を保持具上に滴下してもよい。また保持具にレジスト除去時の汚染物が付着してクロスコンタミネーションを懸念する場合は、必要に応じて保持具11.3を別途手段で洗浄すればよい。この時は、保持具を複数個用意しておけば工程が滞ることはない。

第1図の装置を用いた変形例としては、加熱リソングリ(H_3PO_4)を用いてウェーハ上の Si_3N_4 膜を除去する処理がある。この場合、リソングリの使用量はごく少量で可能であるため、安全性が確保され、さらにプラズマを用いて処理方法に比べ、はるかに安価な装置で可能であり、さらに下地基板をおかすこともなく、ダメージもまったく入ら

なかつた。

さらに別の変形例としては処理液にフッ化アンモニウム(NH_4F)溶液や希釈フッ酸を用いて SiO_2 膜をエッチング除去したり、有機系アルカル溶液を用いてシリコンをエッチング除去したりした。本実施例では、保持具を高純度のCVD法で形成された SiC 膜で作製した。

次にウェーハ裏面の酸化膜を除去する処理工程に適用した実施例を第2図を用いて説明する。第2図(b)は同図(a)の部分Aの拡大図である。10mmの厚さで、150mmの直径のカーボン板21.1に、直径2mm、深さ2mmのザグリ孔(有底孔)21.2を4mmピッチでほぼ全面に設け、そのうち約30%の孔の底部に1mm直径の貫通孔21.3を形成した。このようなカーボン板21.1の全面にCVD法で SiC 膜を約50μm堆積し、処理液保持具21.4とした。この保持具外周部に間隔的に例えば3ヶ所の凸起部21.5を設け、ウェーハ21.7との間隙調整に利用した。本実施例では凸起部21.5を1.5mm高さにした。また上述

の処理液保持具214上にフッアンモニウム(NH_4F)水溶液216を、ザグリ孔212から少し盛りあがる程度にまで滴下した。次に被処理基板217の処理面(この場合はウエーハ裏面)を NH_4F 水溶液に接するようにしながら、上述凸起部215上に載置した。表面張力により図示するように NH_4F 水溶液216は、ウエーハ裏面全体に拡がる。処理液216をザグリ孔212に滴下している時、貫通孔213の内部にも処理液は流入するが、表面張力により下部にもれていくことはない。ただしウエーハ裏面が処理液に接した時にその時の圧力で貫通孔213内の処理液がもれない程度に滴下量を調整するのが望ましい。また、処理液と基板処理面が接する時、空気(気泡)がまきこまれないように、互に傾斜を持たせてウエーハと保持具を接するようにしていくといい。上記の基板を、処理が終了して持ちあげる際、基板と保持具で形成される空隙部に、貫通孔213を通して空気が流入し、比較的容易に両者を引きはがすことができる。

第2の変形例として、第3図に示すように上述の処理液保持具214の底部に密閉空間251を設け、該空間内の圧力を調整できる機構(図示では N_2 ポンベ254と圧力調整弁255)を併設しておく。処理液216を保持具に滴下した後、該空間内の圧力を調整して基板処理面と処理液が接するようにしたり、処理中に空間内圧力を増減させて処理液216に振動を与える、処理液の拡がりを促進させることもできる。

さらに、基板を持ちあげる場合、空間251内の圧力を調整して貫通孔213を通してのガスの流入を容易にするなど有用である。また、空間251内にガスでなく処理液そのものを入れ、貫通孔213を通して処理液216の供給を行い、かつ処理終了後、処理液を回収することも可能である。さらに該密閉空間の底部252に超音波発振子253を付設し、処理液に振動を与えること、温度調整機構を設け、処理液および処理中の温度制御を行なうことも可能である。

次にシリコンウエーハにTAB用Alバンプメ

ッキ処理を行なった実施例を、第4図を用いて説明する。直径175mmの石英で作られた基板支持容器311とこれとほぼ同径の処理液保持具312があり、これらで密閉空間が形成できるよう、容器外周にはOリング313が埋設されている。容器311の中央部に凸起部310を設け、Alメッキ処理がなされる125mm直径のウエーハ314が載置される。凸起部310にはメッキ用電極315が設けられており、ウエーハと該電極の接触を良好にするため、ウエーハの真空チャック機構316を併設してもよい。また該凸起部310にはウエーハ314の上げ下げを容易にするため、切り込み317を設けてもよい。密閉容器内圧力を調整するためのガス供給機構318やドレイン(ガス排出)機構319が容器に設かれている。前述の処理液保持具312はステンレスで作られ、すべての面はテフロン加工がなされているが、ウエーハと対向する面はPVC膜が表面処理されている。また、ウエーハとの対向面には多數の貫通孔309が開口されている。また上記

保持具の処理液内蔵空間320に連結するように処理液供給機構321があり、該供給機構で上記内蔵空間320の処理液圧力を調整が可能になっている。しかし、密閉容器内圧力と処理液圧力のバランスをとりながら、被処理基板314と保持具312の間隙にメッキ液322を満たす。そして保持具312と凸起部メッキ用電極315間に直流電源323を接続しメッキを行なう。この時、メッキ液の循環を改善するため、保持具他面に超音波振動子324を付設し超音波を加えてよいし、メッキ液供給機構321を用いて、メッキ途中で前記間隙のメッキ液を内蔵空間320のメッキ液と入れかえるような操作を行なってよい。また必要に応じ、加熱ランプ325により基板314を加熱することができるし、加温したメッキ液を供給してもよい。

本実施例ではウエーハ裏面がメッキ液322に接しないため、前記従来例のように裏面が汚れることも、電極にAlがメッキされることもなく、良好にAlバンプメッキが行なえた。さらにメッ

ギ液が密閉空間にあるため、メッキ液が外部にもれることもなく、安全上にも利点があった。

上述の第4図の装置を用いて、メッキ液のかわりに現像液を用いて現像することも可能であった。当然この場合はメッキ用電源323や電板は不用である。本実施例では現像液が瞬時にウエーハ面をおおうことが可能となるため、現像むらがなく均一な現像が達成できた。さらに200mm直径のウエーハ上でも何ら問題なく、均一性よく現像が可能となつた。

さらに第4図の他の変形例として、現像液のかわりに、飽和状態まで溶解させたH₂SiF₆水溶液にAl等を溶解させた処理液を用いることにより、基板上にSiO₂膜を堆積させることができた。この場合、基板のみを加温(60~80°C)できるため、異状析出等の問題もなく、堆積速度も大きくとることが可能であった。

更に他の変形例として、シランカップリング剤(例えばウエーハとフォトレジストの接着用)処理に上述装置を適用したものについて説明する。

ここでシランカップリング剤溶液を適当に希釈して該溶液を直接塗布処理してもよいし、従来例と同様に蒸気で処理する場合には、第5図に示すように前述処理液保持具312の前面を多孔質物体351でおおうようにして、本発明での流体として、蒸気のみが通過してくるようにして処理してもよい。該多孔質物体351としては、カーボンやセラミックなどからなる多孔質物質を用いてもよいし、紙や布等を用いてもよい。この実施例ではシランカップリング剤はウエーハ裏面には塗布されないためパーティクルの発生がなく良好であった。

次にフォトレジストの塗布を行う実施例を第6図を用いて説明する。すなわち、回転および上下移動可能なウエーハ支持チャック411にウエーハ412を、真空チャック等の手段で固定する。フォトレジストを保持する保持具413にはレジストの供給機構414、レジスト415を内蔵できる空間がある。またウエーハ412と対向する面416は、多孔質物体(実施例では紙状に漉かれたテフロンシートを用いた)で作られている。

ト溶剤濃度を減少させる。

第6図による本装置を用いて、シランカップリング剤処理を行なうことも可能であり、また現像処理にも適していることは自明である。

液晶表示装置等の製造に用いられるガラス等の大型基板の処理の実施例を第7図を用いて説明する。ガラス基板511が基板転送ローラー512上に載置され、転送可能にしてある。該基板511の上方に処理液でおかされない布(例えば漉かし法で製作されたテフロン紙やポリアミド、ポリエーテルケトン等のいわゆるエンジニアリングプラスチック繊維で編まれたメッシュや布状のものでもよい)で作られた無端布ベルト513があり、これは複数個のベルト回転用ローラー514で回転するようになっている。この布ベルトに処理液を供給する処理液供給機構515も併設されている。

以上からなる処理液保持具516を基板511に近接して設置し、処理液が523基板処理面に接するようにする。そして基板511を転送させ

本実施例によると、レジスト飛散時、ウエーハ上方にレジストを大量に内蔵した保持具が存在しているため、これからレジスト溶剤が揮発し、ウエーハ近傍はレジスト溶剤で充満している。このためレジスト乾燥が起りにくくなり、低速回転で所望の膜厚を得ることができ、かつレジストの消費量も従来方法に比べて1/3~1/10で塗布が行えた。ところでウエーハ近傍のレジスト溶剤濃度がいつまでも高いとレジストが乾燥せず、一定膜厚になりにくい。

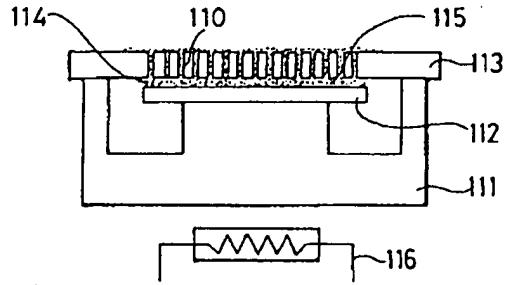
このため所望膜厚になった後に、前述ウエーハチャック411をさらに下方に移動させ、レジス

ながら処理を行なう。処理終了後、基板表面に残存している処理液523を除去・洗浄するため、洗浄機構517がある。これは中心部に洗浄水518を供給する洗浄水供給部519、これを囲むように、使用済み洗浄水および残存処理液を回収する減圧状態の回収部520からできており、供給部先端には洗浄水量調整のために多孔質物体521があり、これで水量を調整し、基板表面が洗浄できるようにする。さらに洗浄水の残存を除去するために、含水性に富んだ布からなる拭きとり機構522があり、必要に応じさらに乾燥機構も設けててもよい。

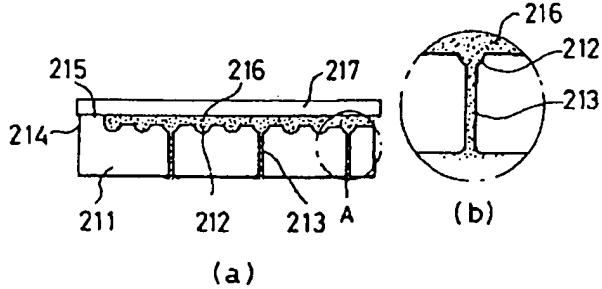
このようにすれば大型基板511でも、ごく少量の処理液で効率よく処理することができた。

【発明の効果】

本発明の処理装置及び処理方法を用いれば、少量の処理用流体で安全かつ効率的に基板処理が行なえるし、さらに基板裏面からの汚染もまったく問題にならなくなつた。



第1図



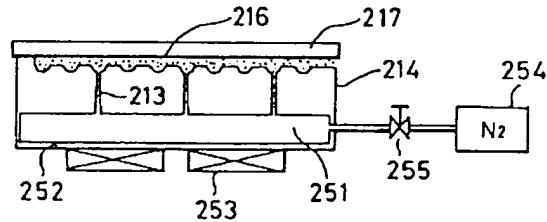
第2図

4. 図面の簡単な説明

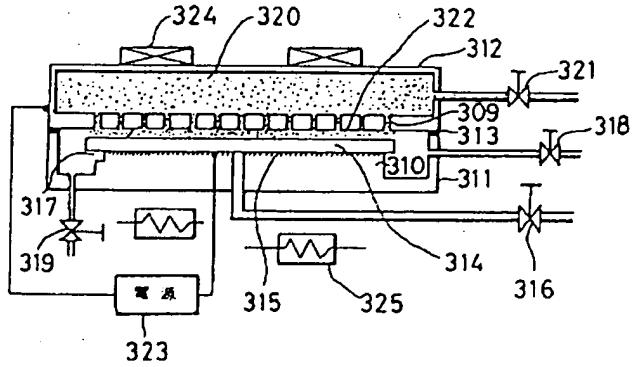
第1図ないし第7図は本発明の各実施例の構成図、第8図ないし第11図は従来の基板処理を示す構成図である。

112, 217, 314, 412, 511…被処理基板、113, 214, 312, 413, 516…流体保持具、110, 213, 309…流体通過孔、115, 216, 322, 415, 523…処理用流体、212…ザグリ孔（有底孔）、215…凸起部、320…流体貯蔵部。

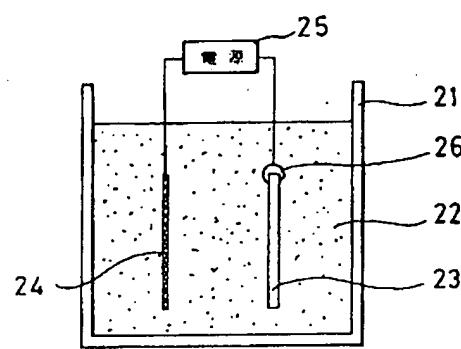
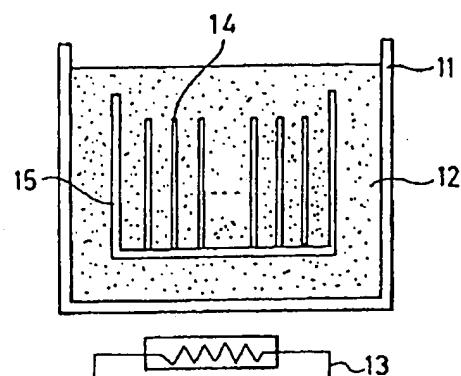
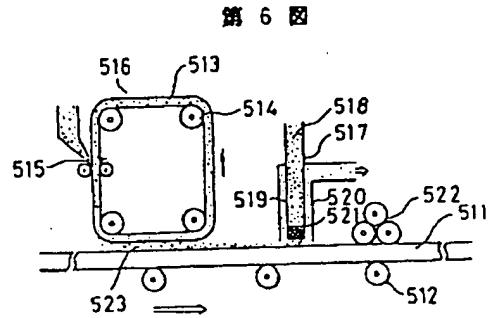
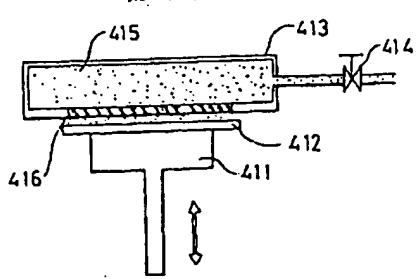
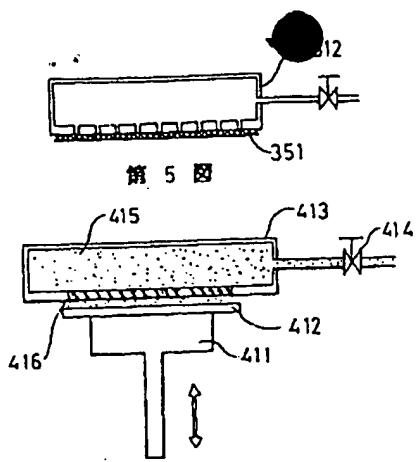
出願人代理人 弁理士 鈴江 武彦



第3図



第4図



第 7 図

第 9 図

